

ME2110



ME2110 系列 DC/DC 升压转换器

概述

ME2110 系列 DC/DC 芯片是采用 CMOS 工艺制造的低静态电流的 PFM 开关型 DC/DC 升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问题,减小对周围电路的干扰。输出电压为 1.8V~6.0V (按 0.1V 的级差)。对内置开关晶体管的ME2110Xxx,组成 DC/DC 升压电路只需接三个外围元件,一只肖特基二极管、一只电感和一只电容。带 CE 端的ME2110Cxx,具有关断功能,可使芯片功耗达到最小。该系列芯片适用于低噪声、较大电流的电池供电设备。

应用场合

- 电池供电设备的电源部分
- 无线鼠标、无线键盘、照相机、摄像机、VCR、PDA、 手持电话、电动玩具等便携式设备的电源部分
- 要求提供电压比电池所能提供电压高的设备的电源 部分

特点

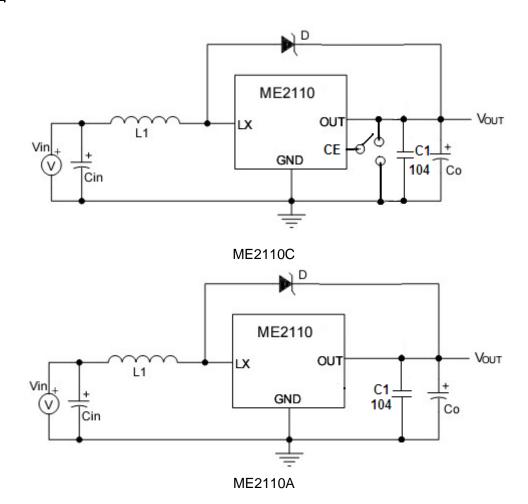
- 只需少量的外接元件:仅一只肖特基二极管、一只电 感和一只电容
- 低纹波及低噪声
- 工作电压范围: 0.9V~6.0V
- 带载能力强: 当 Vin=1.2V 且 Vout=1.9V 时 lout=100mA
- 输出电压范围: 1.8V~6.0V(步长 0.1V)
- 输出电压高精度: ±2%
- 低启动电压:最高值为 0.9V(输出电流为 1mA 时)
- 最大工作频率: 360KHz(典型值) (TYP. ME2110C25)
- 高效率: 典型值为 85%

封装形式

- 3-pin SOT23-3 SOT89-3
- 5-pin SOT23-5



典型应用图

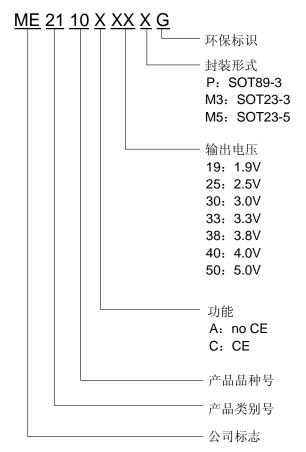


元件:

- 电感: 22uH(Sumida)
- 二极管: IN5817、IN5819
- 电容: Cin, Co:100uF/16V(钽电容); C1:104



选购指南



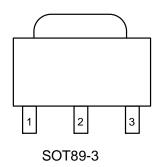
产品型号	输出电压 VOUT	开关晶体管	CE 端	特点	封装形式
ME2110A50PG	5.0V	内置	No	Lx	SOT89-3
ME2110A33M3G	3.3V	内置	No	Lx	SOT23-3
ME2110A38PG	3.8V	内置	No	Lx	SOT89-3
ME2110A40PG	4.0V	内置	No	Lx	SOT89-3
ME2110A50M3G	5.0V	内置	No	Lx	SOT23-3
ME2110C33M5G	3.3V	内置	Yes	Lx CE	SOT23-5
ME2110C50M5G	5.0V	内置	Yes	Lx CE	SOT23-5

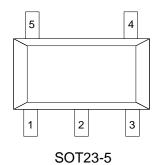
注: 此产品目前有七种电压值: 1.9V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.8V, 4.0V, 5.0V。

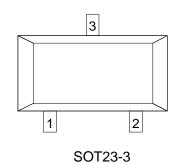
[,]如果您需要其他电压值和封装形式的产品,请联系我司销售人员。



产品脚位图







脚位功能说明

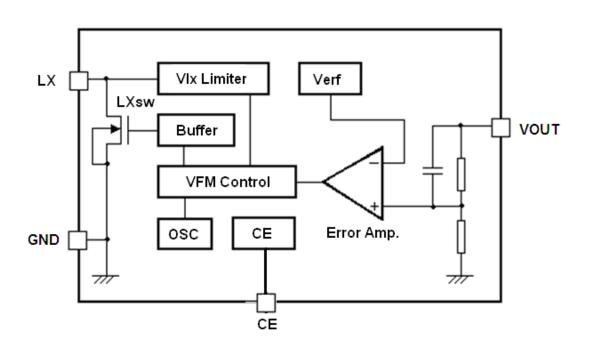
ME2110Axx

引脚	号	符号	引脚描述
SOT89-3	SOT23-3	11 2	が神色を
1	1	GND	接地引脚
2	3	V _{OUT}	升压输出引脚
3	2	Lx	开关引脚

ME2110Cxx

引脚号		引脚描述
SOT-23-5	10.2	が神色を
1	CE	使能端
2	V _{OUT}	升压输出引脚
3	NC	空
4	GND	接地引脚
5	Lx	开关引脚

芯片功能示意图





绝对最大额定值

	参数	符号	极限值	单位
V _{IN}	脚电压	V _{IN}	6.5	V
Lx	脚电压	V_{LX}	6.5	V
CE	脚电压	V _{CE}	-0.3~Vout+0.3	V
	V _{OUT} =1.9V~2.5V		800	
Lx 脚输出电流	V _{OUT} =2.5V~4.0V	I _{LX}	1300	mA
	V _{OUT} =4.0V~5.0V		2000	
Vdd	输入电压	V_{dd}	6.5	V
	SOT89-3	Pd	1.25	W
允许最大功耗	SOT23-5	Pd	0.60	W
	SOT23-3	Pd	0.54	W
	SOT89-3	θ_{JA}	100	°C/W
封装热阻	SOT23-5	θ_{JA}	210	°C/W
	SOT23-3	θ_{JA}	230	°C/W
工	作温度	T _{Opr}	-25~+85	$^{\circ}$ C
存	贮温度	T _{stg}	-55~+150	$^{\circ}$
:	结温	T _J	-40~+150	$^{\circ}$
焊接温	且度和时间	T _{solder}	260℃, 10s	

电气参数

ME2110A19 F_{osc}=150KHz (V_{IN}=V_{OUT}×0.6,I_{OUT}=10mA,T_{opt}=25℃. 有特殊说明除外)

符号	含义	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压		V _{OUT} ×0.98	V _{OUT}	V _{OUT} ×1.02	V
V _{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA,V _{IN} : 0→2V	-	0.80	0.90	٧
V_{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V	-	0.45	-	٧
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 V _{out} =V _{out} ×0.95,	-	27	-	μΑ
I _{DD2}	输入电流 2	V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V	-	4.5	-	μΑ
I _{LX}	开关管合闸电流	V_{LX} =0.4 V , V_{OUT} = V_{OUT} \times 0.95	-	100	-	mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	V _{OUT} =V _{LX} =6V	-	-	0.5	μΑ
F _{osc}	振荡频率	V _{OUT} =set V _{OUT} ×0.95	-	150	-	KHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side	-	84	-	%
EFFI	效率		-	85	-	%

ME2110C25 F_{osc}=360KHz (V_{IN} =V_{OUT}×0.6, V_{CE} =V_{OUT} , I_{OUT}=10mA, T_{opt}=25℃. 有特殊说明除外)

符号	含义	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压		V _{OUT} ×0.98	V _{OUT}	V _{OUT} ×1.02	٧
V _{start}	启动电压	$I_{OUT}=1$ mA, V_{IN} : $0\rightarrow 2V$	-	0.84	0.90	V



V_{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V	-	0.33	-	V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 V _{out} =V _{out} ×0.95,	-		-	μΑ
I _{DD2}	输入电流 2	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V	-	7	-	μΑ
I _{DD3}	输入电流 3	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V,V _{CE} =0V	-	-	1.0	μΑ
I _{LX}	开关管合闸电流	无外部元件 V _{LX} =0.4V,V _{OUT} =set V _{OUT} ×0.95	-	100	-	mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	V _{OUT} =V _{LX} =6V	-	-	0.5	μA
F _{osc}	振荡频率	V _{OUT} =set V _{OUT} ×0.95	-	360	-	KHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side	-	77	-	%
EFFI	效率		-	85	-	%

ME2110C33 F_{osc}=360KHz (V_{IN}=V_{OUT}×0.6, V_{CE}=V_{OUT}, I_{OUT}=10mA, T_{opt}=25℃. 有特殊说明除外)

WILZ 110033	1 0SC=3001(112 (VIN = VOU) /	(0.0) VCE = VOUL (1001 = 10111A)	opt-20 C.	11 11 1/1 10	.)1 LSV \ I)	
符号	含义	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压		V _{OUT} × 0.98	V _{OUT}	V _{OUT} × 1.02	V
V_{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 0→2V	-	0.84	0.90	V
V_{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V	-	0.33	-	V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} ×0.95,	-	110	-	μΑ
I _{DD2}	输入电流 2	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V	-	7	-	μΑ
I _{DD3}	输入电流 3	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V,V _{CE} =0V	-	-	1.0	μΑ
I _{LX}	开关管合闸电流	无外部元件 V _{LX} =0.4V,V _{OUT} =set V _{OUT} ×0.95	-	100	-	mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	V _{OUT} =V _{LX} =6V	-	-	0.5	μΑ
F _{osc}	振荡频率	V_{OUT} =set $V_{OUT} \times 0.95$	-	360	-	KHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side	-	77	-	%
EFFI	效率		-	85	-	%

ME2110C50 F_{osc}=310KHz (V_{IN}=V_{OUT}×0.6, V_{CE}=V_{OUT} ,I_{OUT}=10mA,T_{opt}=25℃. 有特殊说明除外)

符号	含义	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压		$V_{OUT} \times 0.98$	V _{OUT}	$V_{OUT} imes 1.02$	V
V_{start}	启动电压	$I_{OUT}=1$ mA, V_{IN} : $0\rightarrow 2V$	-	0.85	0.90	V
V_{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V	-	0.38	-	V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 V _{our=} V _{out} ×0.95,	-	165	1	μΑ
I _{DD2}	输入电流 2	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V	-	8	-	μΑ
I _{DD3}	输入电流 3	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V,V _{CE} =0V	-	-	1.0	μΑ
I _{LX}	开关管合闸电流	无外部元件	-	110	-	mA



		V_{LX} =0.4V, V_{OUT} =set $V_{OUT} \times 0.95$				
I _{LXleak}	开关管漏电流	V _{OUT} =V _{LX} =6V	-	1	0.5	μΑ
F _{osc}	振荡频率	V_{OUT} =set $V_{OUT} \times 0.95$	-	310	-	KHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side	-	74	-	%
EFFI	效率		-	85	-	%

ME2110A50 F_{osc}=310KHz(V_{IN}=V_{OUT}×0.6, I_{OUT}=10mA, T_{opt}=25℃. 有特殊说明除外)

符号	含义	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压		V _{OUT} × 0.98	V _{OUT}	V _{OUT} × 1.02	V
V_{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 0→2V	-	0.85	0.90	V
V_{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V	-	0.38	-	V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} ×0.95,	-	165	-	μΑ
I _{DD2}	输入电流 2	无外部元件 V _{OUT} =V _{OUT} +0.5V	-	8	-	μΑ
I _{LX}	开关管合闸电流	无外部元件 V _{LX} =0.4V,V _{OUT} =set V _{OUT} ×0.95	-	110	-	mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	V _{OUT} =V _{LX} =6V	-	-	0.5	μΑ
F _{osc}	振荡频率	V _{OUT} =set V _{OUT} ×0.95	-	310	-	KHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side	-	74	-	%
EFFI	效率		-	85	-	%

注意: 1、Diode 采用肖特基二极管(正向压降约 0.2V),如 IN5817,IN5819

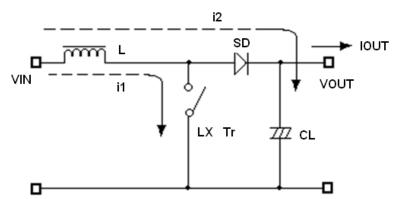
2、电感采用: 22μH (r<0.5Ω)

3、电容采用钽电容: 100uF

工作原理

ME2110 系列升压转换器利用电感对能量的存储,并通过其与输入端电源共同的泄放作用,从而获得高于输入电压的输出电压。如下图:

开关式 DC/DC 升压转换器工作原理图





外部器件的选择及注意事项

外围电路对 ME2110 性能影响很大,需合理选择外部器件:

- 1.外接电容值不宜小于 10μF (电容值过小将导致输出纹波过大),同时要有良好的频率特性(最好使用钽电容)。 此外,由于 LX 开关驱动晶体管关断时会产生一尖峰电压,电容的容压值至少为设计输出电压的 3 倍;(普通的铝电解 电容 ESR 值过高,所以可选购专门应用于开关式 DC/DC 转换器的铝电解电容,如 OS-CON 电容。)
- 2.外接电感值要足够小以便即使在最低输入电压和最短的 LX 开关时间内能够存储足够的能量,同时,电感值又要足够大从而防止在最高输入电压和最长的 LX 开关时间时 I_{LXMAX} 超出最大额定值。此外,外接电感的直流阻抗要小、容流值要高且工作时不至于达到磁饱和;
 - 3.外接二极管宜选择具有较高切换速度的肖特基二极管。

PCB Layout 注意事项:

- 1.外部元器件与芯片距离越小越好,连线越短越好。特别是接到 Vout 端的元器件应尽量减短与电容的连线长度。
- 2.Vss 端应充分接地,否则芯片内部的零电位会随开关电流而变化,造成工作状态不稳定;

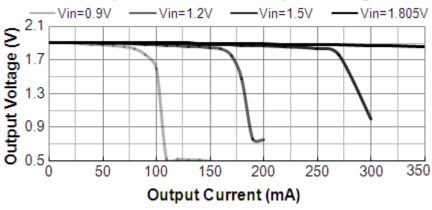


典型性能参数

ME2110A19

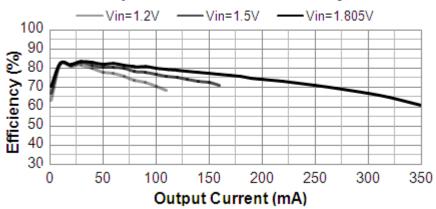
(1)

Output Current vs. Output Voltage

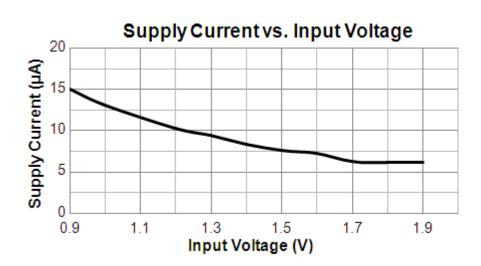


(2)

Output Current vs. Efficiency



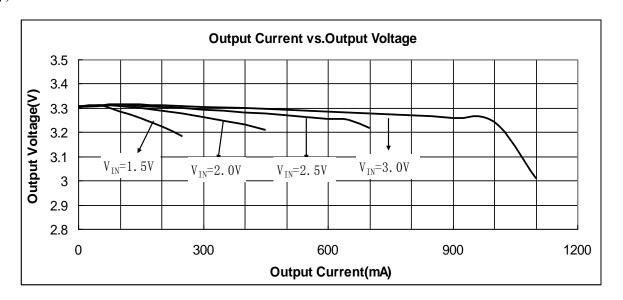
(3)



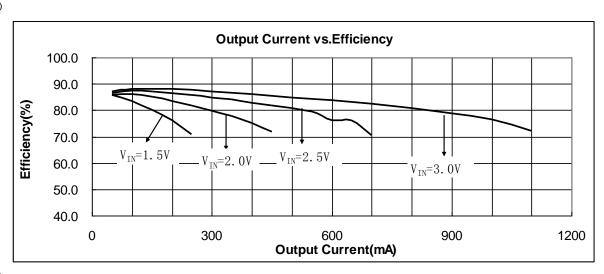


ME2110C33

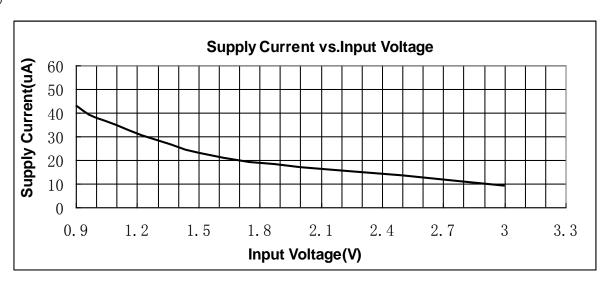
(1)



(2)



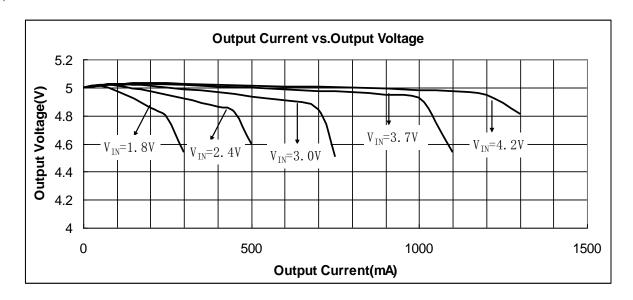
(3)



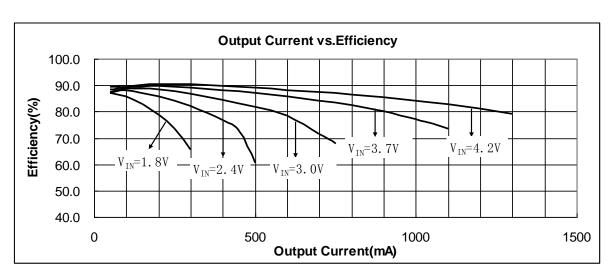


ME2110C50

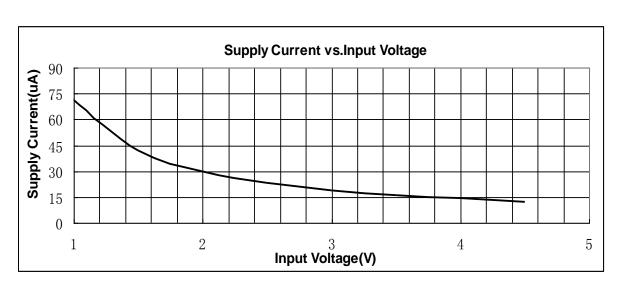
(1)



(2)



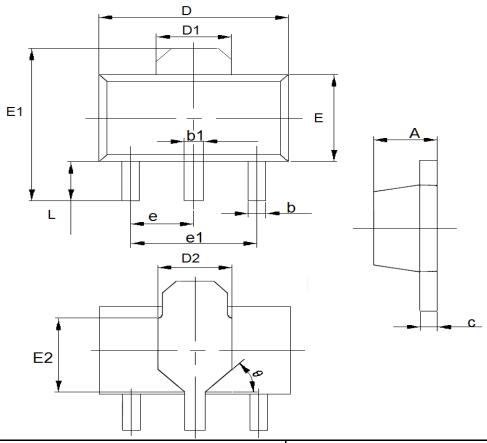
(3)





封装信息

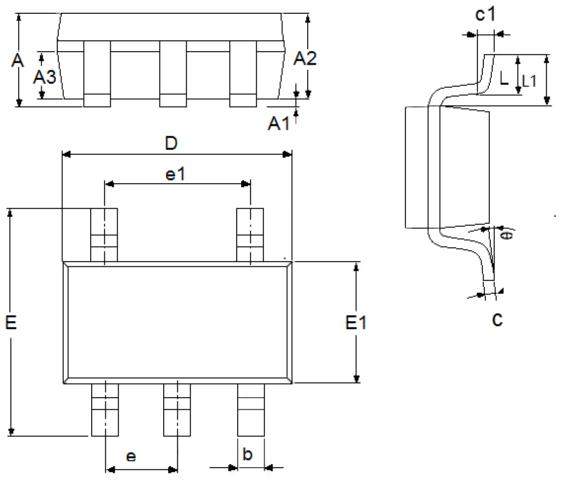
● 封装形式: SOT89-3



全 ₩	尺寸(m	ım)	尺寸(I	Inch)
参数	最小值	最大值	最小值	最大值
А	1.4	1.6	0.0551	0.0630
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205
b1	0.4	0.58	0.0157	0.0228
С	0.35	0.45	0.0138	0.0177
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811
D1	1.55(T`	YP)	0.061((TYP)
D2	1.75(TYP)		0.0689	(TYP)
e1	3.0(TY	P)	0.1181	(TYP)
E	2.3	2.6	0.0906	0.1023
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732
E2	1.9(TY	(P)	0.0748	(TYP)
е	1.5(TY	(P)	0.0591(TYP)	
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472
θ	45°		45	5°



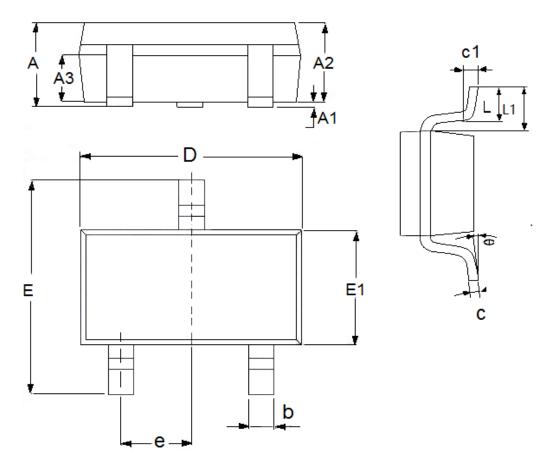
● 封装形式: SOT23-5



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
Α	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
Е	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
е	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	



● 封装形式: SOT23-3



参数	尺寸 (mm)		尺寸(Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
А	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
С	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220
E	2.6	3.1	0.1023	0.1220
E1	1.5	1.8	0.0591	0.0709
е	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	



- 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其 责任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率 发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社 会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安 全设计。